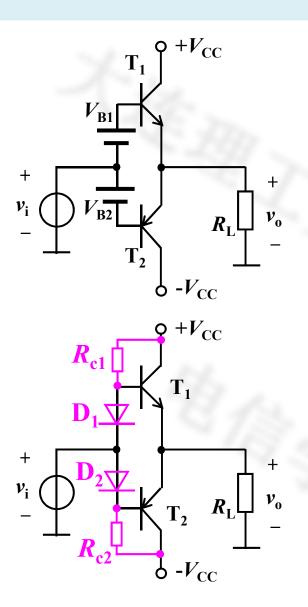
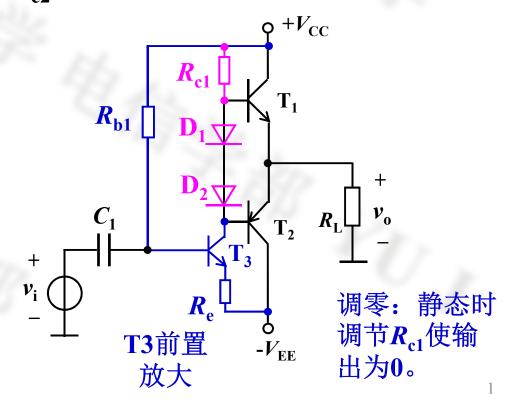
8.4 甲乙类双电源互补对称功率放大电路



给BJT加基极偏置,使它们在静态(v_i =0)时,发射结刚好正偏,工作在甲乙类。

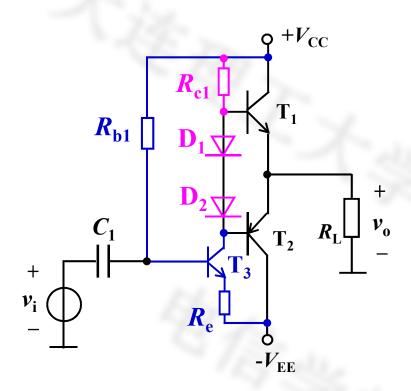
D1、D2提供偏置(假设导通电压相同);

 R_{c1} 、 R_{c2} 使二极管偏置在导通状态。



8.4 甲乙类双电源互补对称功率放大电路

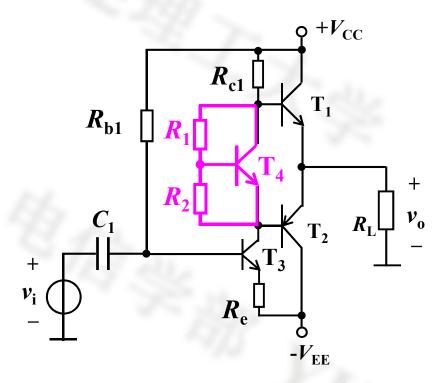
(a) 利用二极管提供偏置电压



缺点: D1和D2产生的 基极偏置电压不能调节。

参数计算: 与乙类功放同

(b)利用三极管恒压源提供偏置



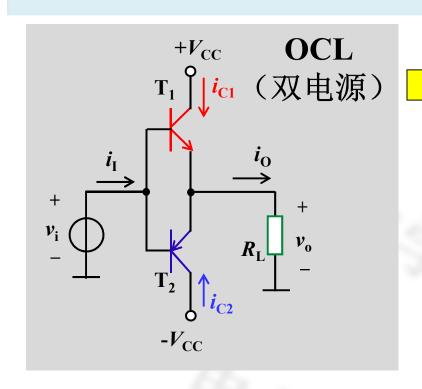
 $V_{\text{CE4}} = (R_1 + R_2) V_{\text{BE4}} / R_2$ 偏置电压可调。

称为: $V_{\rm RE}$ 倍增电路

8.5 其他类型功率放大器

- 1. 单电源互补对称功放电路
 - **OTL (Output TransformerLess)**
- 2. 采用复合管(达林顿管)的互补功放
- **Output Stage Utilizing Darlington Configuration**
- 3. 集成功率放大器 ICs of Power Amplifiers

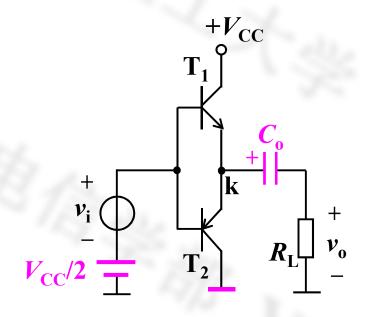
1. 单电源互补对称功放电路





OTL(无输出变压器)→单电源

(Output TransformerLess)



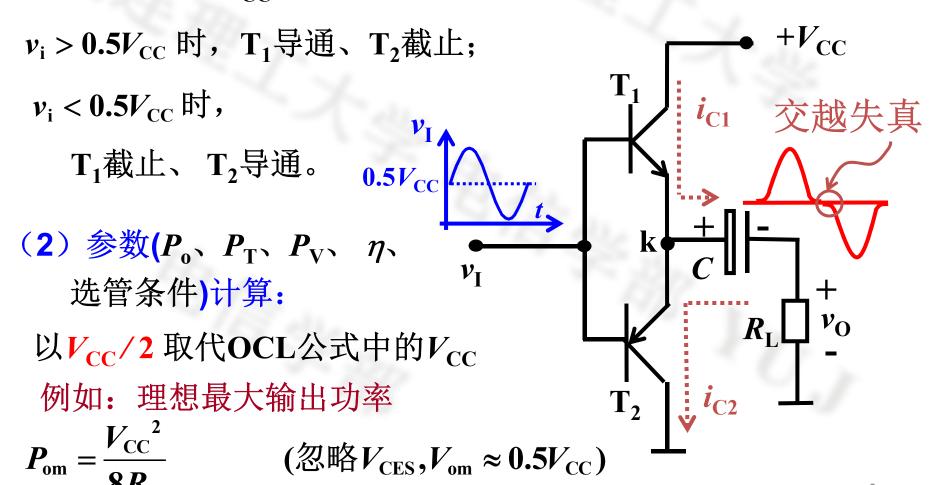
静态($v_i = 0$): $V_k = V_{CC}/2$

电容器
$$C_0$$
选择: $C_0 \ge (5-10) \frac{1}{2\pi R_L f_L}$

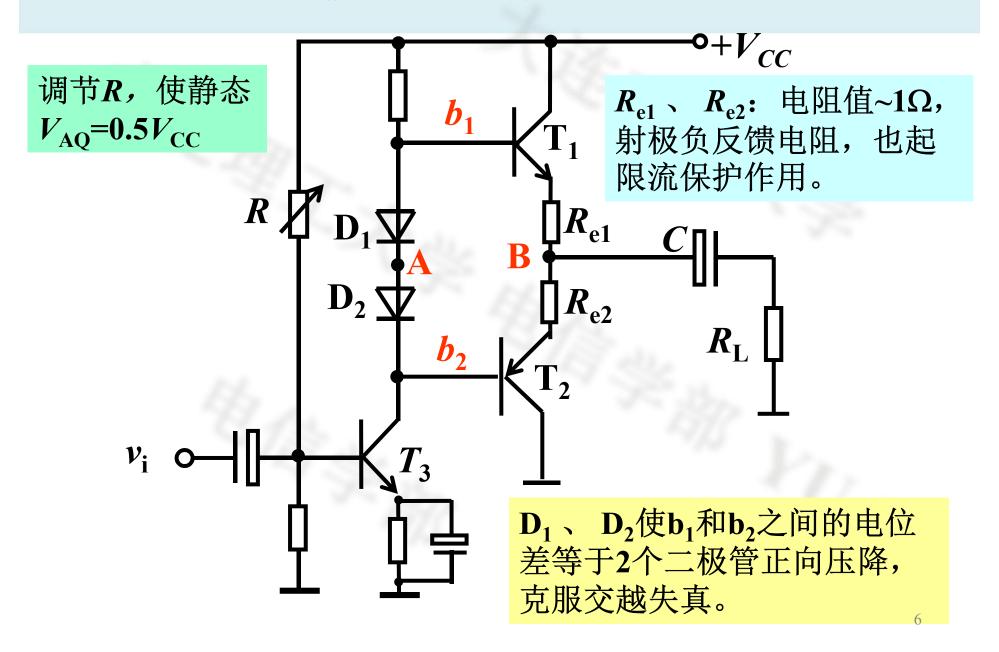
1. 单电源互补对称功放电路

(1) 动态分析

设输入端在 $0.5V_{CC}$ 直流电平基础上加入正弦信号。

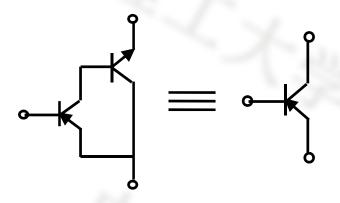


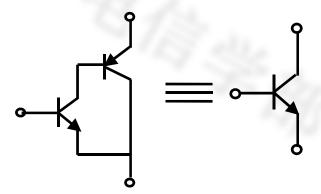
实用的OTL互补输出功放电路

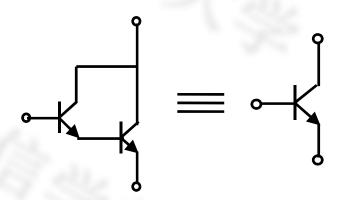


2. 采用复合管(达林顿管)的互补功放

当输出功率较大时往往采用复合管 由NPN、PNP复合而成 复合管有四种形式: 复合管极性=前面管极性







Ref: page 151

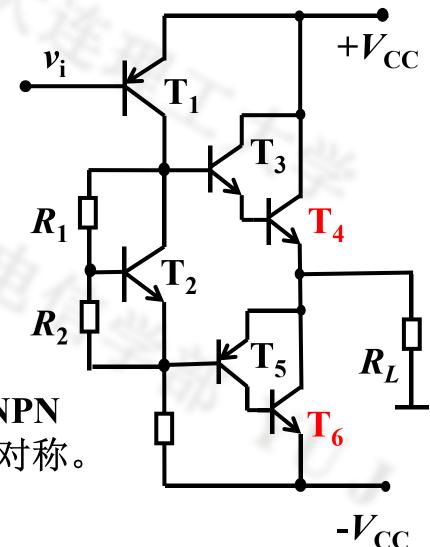
改进后的OCL准互补输出功放电路:

T₁: 前置放大级 (电压推动级)

 $\mathbf{T_2}$ 、 R_1 、 R_2 : V_{RE} 倍增电路

 T_3 、 T_4 、 T_5 、 T_6 : 复合管构成的输出级

输出级中的 T_4 、 T_6 均为NPN型晶体管,两者特性容易对称。



3. 集成功率放大器

广泛用于音响、电视和小电机的驱动方面;

大多数集成功率放大器 = 运算放大 + 互补功放;

使用方法原则上与集成运放相同;

注意极限参数(功耗、最大允许电源电压等);

一般加有足够大的散热器;

特点:工作可靠、使用方便;只需在器件外部适当连线,即可向负载提供一定的功率;

集成功放LM380:

集成功放LM384:

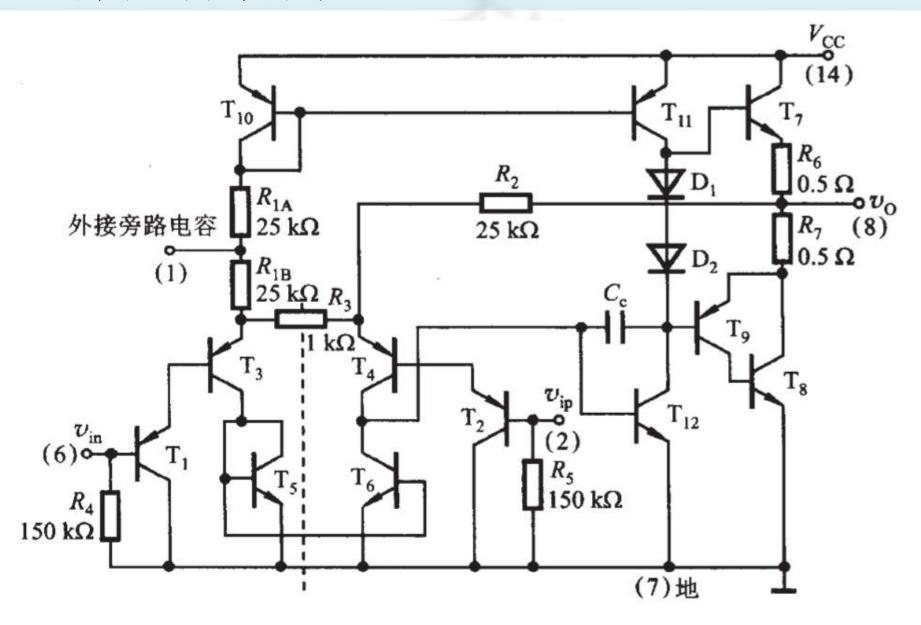
生产厂家:美国半导体器件公司

电路形式: OTL

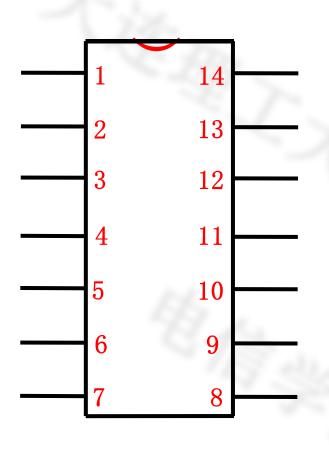
输出功率: 8Ω负载上可得到2.5W功率 ···5W功率

电源电压:最大为22V 最大为28V

3. 集成功率放大器 集成功放 LM380内部电路:



3. 集成功率放大器

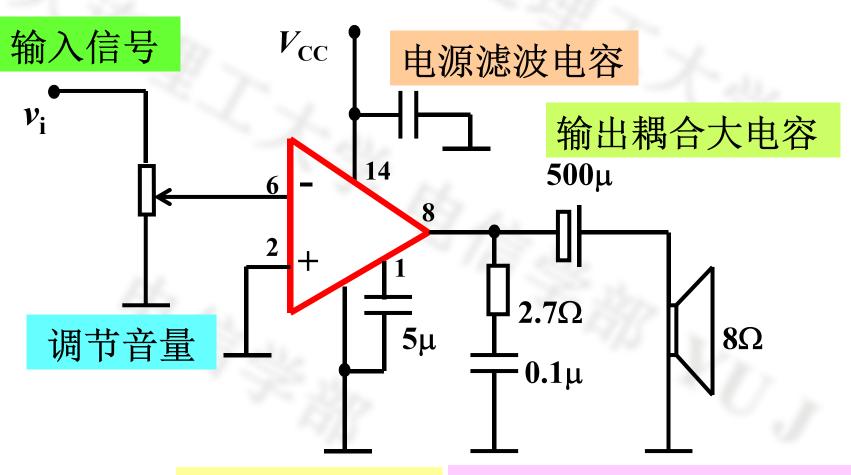


集成功放 LM380管脚说明:

- 14 -- 电源端(V_{CC})
- 3、4、5、7-接地端(GND)
- 10、11、12 接地端 (GND)
- 2、6-输入端(一般2脚接地)
- 8-输出端(经电容接负载)
- 1- 接旁路电容
- 9、13 空脚 (NC)

3. 集成功率放大器

集成功放 LM384 外部电路典型接法:



外接旁路电容

低通滤波,去除高频噪声

其它功放: 变压器耦合式功放电路

例: OCL电路中,若 R_L =80 Ω 、需要输出功率 P_0 =50W。

根据公式
$$P_{\text{om}} = \frac{V_{\text{CC}}^2}{2R_{\text{L}}}$$

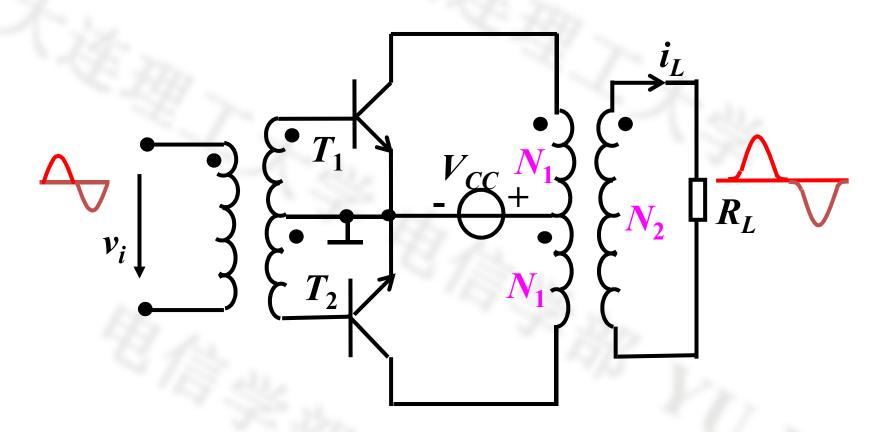
得电源电压: $V_{\text{CC}} = \sqrt{80 \times 50 \times 2} \approx 90 \text{V}$

90V的电压对电子电路显然不合适。

利用变压器阻抗变换关系($R_L = K^2 R_L'$), 把阻抗变小,便可解决以上问题。

乙类变压器耦合式推挽功率放大器

1. 原理电路



放大器: 由两个共射极放大器组成,两个三极管的射极接在一起。

提高最大允许功耗 P_{CM} 的方法——加散热片

电源供给功率 $P_{V} = P_{o} + P_{T}$

一部分转换为负载的有用功率 P_0 ,

另一部分 P_{T} 则消耗在功率管的集电结,变为热能而使管芯的结温上升。

如果晶体管管芯的温度超过管芯材料的最大允许结温 $T_{\rm jM}$ (锗管 $T_{\rm jM}$ 约为75°C~100°C,硅管 $T_{\rm jM}$ 约为150°C~200°C),则晶体管将永久损坏。这个界限称为晶体管的最大允许功耗 $P_{\rm CM}$ 。

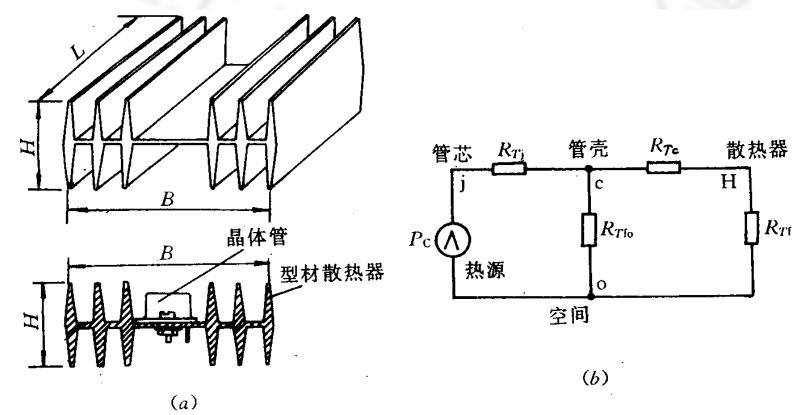
如何降低温度?

提高最大允许功耗 P_{CM} 的方法——加散热片

实质:减小热阻! (计算略)

热阻:描述热传导阻力大小的物理量,记为 R_{T} 量纲为 $^{\circ}$ C/W,

它表示每消耗1W功率结温上升的度数。



第8章 功率放大电路

小结

掌握: 功放分类与特点(大 P_0 , 高 η)

掌握: 四大参数计算方法

(OTL: $V_{\rm CC}$ /2代替公式中的 $V_{\rm CC}$)

掌握: 选功率管的原则

掌握: 交越失真现象和避免方法

预习:模拟集成电路-差分式放大电路

作业

P408: 8.4.3, 8.4.5

